

NXP, PoE 애플리케이션용 동급 최고 MOSFET 솔루션 출시

새 NextPower Live MOSFET, 경쟁사 대비 돌입전류 용량 두 배 제공해 고성능 PoE 애플리케이션에 이상적

2013년 4월 18일 - NXP 반도체(NASDAQ: NXPI)는 오늘 PoE(Power of Ethernet) 애플리케이션을 위해 설계된 새로운 NextPower Live MOSFET(넥스트파워 라이브 MOSFET) 제품군을 출시했다. NXP의 강력한 전력 MOSFET에 기반한 새로운 제품인 [PSMN040-100MSE](#)와 [PSMN075-100MSE](#)는 경쟁사 대비 돌입전류(Inrush Current) 용량을 두 배로 제공해 PoE+, UPoE, LTPoE++와 같은 30W 이상의 고성능 PoE 아키텍처에 이상적이다.

PoE는 별도의 서플라이를 사용하는 대신 이더넷 케이블이나 포트를 통해 기기에 전원을 공급하는 일반적인 방법으로 떠오르고 있다. 초기에는 VoIP 전화와 같은 저전력 기기용으로 사용됐지만 이제는 UPoE 및 LTPoE++와 같은 새로운 방식으로, 구동을 위해 최대 100W가 필요한 대형 LCD PoS 디스플레이나 3G/4G 무선 액세스 포인트(AP)와 같은 기기도 가능하게 됐다. 그러나 이런 고전력 환경에서 네트워크 라우터, 스위치, 미드스팬(midspan)과 같은 전원공급장치(PSE: power sourcing equipment)는 전원수여기기(PD: powered device)의 단락이나 오류로 전원 서지가 유발될 경우 일어나는 심각한 데미지에도 견딜 수 있어야 한다.

새로운 고전력 시스템들은 그런 장치들을 보호하고 공급하던 MOSFET의 수요를 크게 늘리고 있다. NXP의 새 NextPower Live PoE MOSFET은 보호와 시스템 신뢰성을 더욱 높일 수 있도록 기존 솔루션에 비해 두 배의 용량을 제공하는 SOA(safe operating area)를 제공한다.

NXP의 새 PoE 기기들은 매우 낮은 RDS(on)을 제공하며, 유사한 기기와 풋프린트 호환이 가능한 매우 높은 신뢰성의 LFPK33 패키지로 제공된다.

NXP 반도체 MOSFET 사업부 총괄인 크리스 보이스(Chris Boyce)는 “이더넷을 통한 전력 공급은 보다 광범위한 적용을 위해 PoE 에코시스템 내의 모든 부품에 필요한, 급속하게 발전하고 있는 기술”이라며, “새로운 고전력 표준은 고성능 보호 솔루션을 필요로 한다.

NXP의 이 새로운 기기는 기존 PoE MOSFET의 두 배 용량을 제공하며, 고전력 PoE의 지속적인 적용에 중요한 역할을 담당할 것으로 믿는다”고 밝혔다.

관련 링크

- PSMN040-100MSE: <http://www.nxp.com/pip/PSMN040-100MSE>
- PSMN075-100MSE: <http://www.nxp.com/pip/PSMN075-100MSE>
- NXP의 표준 MOSFET: <http://www.nxp.com/mosfets/>